# ナイキスト周波数以上の LCL 共振周波数を有する 系統連系インバータの電流制御法

木下 徹規\* 渡辺 大貴 伊東 淳一(長岡技術科学大学)

Grid Current Feedback Control Method for *LCL*-type Grid-tied Inverter with *LCL* Resonance Frequency above Nyquist Frequency Tetsunori Kinoshita\*, Hiroki Watanabe, Jun-ichi Itoh, (Nagaoka University of Technology)

This paper proposes a current control method for a grid-tied inverter with *LCL* resonance frequency above the Nyquist frequency. Typically, the resonance frequency is decided below the Nyquist frequency to avoid the Nyquist frequency of the grid-tied systems. The proposed current control stabilizes the grid-tied systems under above Nyquist frequency condition in order to minimize the volume of the *LCL* filter. Especially, the proposed current control effectively suppresses the resonance peak. Accordingly, the inverter robustness against the grid impedance variation and the dynamic performance are significantly enhanced. The detail of the proposed method and design strategy is introduced with the design procedure and the design example. Finally, the validity of the theoretical analysis is demonstrated by a 1-kW prototype with and without active damping.

**キーワード**:系統連系インバータ,*LCL*フィルタ,電流制御,アクティブダンピング,ナイキスト周波数,マルチレベル (Keywords, Grid-tied inverter, *LCL* filter, Current control, Active damping, Nyquist frequency, Multi-level)

#### 1. はじめに

太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギー利用 の一形態として、分散型発電システムの検討が盛んに行わ れている<sup>(1)</sup>。太陽光発電では系統連系インバータを用いて太 陽電池の発電電力を系統へ供給する。また系統連系インバ ータには電力品質を確保する目的で、高調波を含まない交 流出力が系統連系規程により要求されている<sup>(2),(3)</sup>。一般的 に、スイッチング周波数成分の高調波を減衰させるために LCフィルタ、もしくはLCLフィルタがインバータ出力端に 接続される。特にLCLフィルタは高調波に対する高い減衰 効果に加え、フィルタ体積を大幅に削減可能であるため広 く使用されている<sup>(4)-(9)</sup>。

一方で, LCL フィルタを適用した系統側電流フィードバ ック制御系では, LCL の共振周波数 f, とサンプリング周波 数 fs の比によってシステムが不安定化する可能性があり, この時のシステムの安定条件はこの比が 1/6 以上となるこ とが先行研究により明らかになっている<sup>(5)(7)</sup>。これは制御遅 延(1サンプリングの演算遅延, PWM 遅延)により,システ ムの開ループ特性の位相が遅れ, LCL 共振周波数より低い 周波数帯域で位相特性が-180°を通過するためである。しか し, LCL 共振自体を減衰させているわけではないため,フ ィルタ共振によって, 電流制御帯域が制限される可能性は 依然として残っている。

これに対して、フィルタ共振を抑制することでシステム

の不安定化を回避する手法が多数提案されている。その一 例である,アクティブダンピングは主回路部品の追加なし にシステムを安定化させることができる<sup>(の・(7)</sup>。アクティブダ ンピングを実装する一手法として,フィルタキャパシタ電 流をフィードバックする手法がある。この方式では制御的 に共振に対するダンピングを行い,フィルタキャパシタに 対して,並列にダンピングを行い,フィルタキャパシタに 対して,並列にダンピング抵抗が接続された状態を模擬す る。これにより仮想抵抗による LCL 共振に対する減衰効果 が期待できる<sup>(0)</sup>。ここで,仮想抵抗は制御遅延を考慮するこ とにより仮想インピーダンスとして振る舞うが,仮想イン ピーダンスは 1/6 < *f*:/*f*s < 1/2 の周波数範囲で負性抵抗とな る。負性抵抗は安定判別において右半平面(RHP)に極を発生 させる。そのため安定余裕を確保するためにループゲイン の低下を余儀なくされる。

以上の問題に対し、広い周波数範囲で正の仮想抵抗値と なるアクティブダンピング手法が様々検討されている<sup>(7)-(9)</sup>。 しかし、先行研究の手法では LCL フィルタの LCL 共振周波 数がナイキスト周波数未満(サンプリング周波数の半分)と なるように設計する必要がある。これはスイッチング周波 数成分の高調波による共振を回避するためである。

一方で、フィルタの小型化の観点ではキャリア周波数の 高周波化やマルチレベル変換器の適用が有効である。しか し、上述した設計上の制約によりカットオフ周波数が制限 され、LCLフィルタの小型化の妨げとなる。これに対して、 文献(8)などではナイキスト周波数以上での条件においてシ ステムの安定動作領域を明確化し, LCL フィルタの設計指 針を示している<sup>(8)-(9)</sup>。しかし,従来検討では安定的な系統電 圧を前提としているが,実際には系統側の状態によって,系 統インピーダンスの変動が発生する。その結果,システムが 不安定化する可能性がある。

本論文では、ナイキスト周波数以上のLCL 共振周波数で 設計されたフィルタを有する系統連系インバータの電流制 御法を提案する。本論文の特徴は、アクティブダンピングに よる電圧指令値の更新をキャリアのボトム(サンプリング時 間の半分)で行い、かつ正帰還とすることにより、幅広い共 振周波数範囲で正の仮想抵抗として振る舞い安定化するこ とにある。さらに正の仮想抵抗範囲拡大のために位相遅れ 補償器を追加している。本手法はLCL 共振を抑制可能なた め、システムは系統インピーダンス変動に対してロバスト であり、高い動特性を実現できる。実機検証により理論の妥 当性を検証し、系統インピーダンス 10%以下の条件では系 統電流ひずみ率を 5%以下に抑制できることを確認したの で報告する。

2. システムの説明およびモデリング

#### 〈2·1〉 主回路構成

図1にLCLフィルタを有するフライングキャパシタ(FC) 方式3レベル単相系統連系インバータを示す。単相系統連 系インバータはFC方式の3レベル電圧形インバータとLCL 形の出力フィルタによって構成され,出力フィルタは共通 接続点(PCC: Point of Common Coupling)に接続される。

〈2·2〉 エイリアシングを考慮した系統側電流フィード バック制御の課題

図 2 にキャパシタ電流比例フィードバックアクティブダ ンピング方式を適用した系統電流フィードバックのブロッ ク図を示す。本制御は最も簡単に実装可能なアクティブダ ンピングである。ここで、インバータ出力電圧 vo から系統 電流 ig までのパルス伝達関数は以下のように表せる。

$$G_{v_o \to i_s}[z] = \frac{i_s}{v_o} = \frac{1}{L + L_f + L_g} \left[ \frac{T_s}{z - 1} - \frac{1}{\omega_r} \frac{(z - 1)\sin\omega_r T_s}{z^2 - 2z\cos\omega_r T_s + 1} \right]$$
(1)

ここで,Lはインバータ側インダクタンス, $C_f$ はフィルタキャパシタンス, $L_f$ は系統側フィルタインダクタンス, $L_g$ は系統インダクタンス, $f_r$ は共振周波数, $T_s$ はサンプリング時間である。

図3にLCLフィルタの共振周波数をナイキスト周波数(サ ンプリング周波数の半分)以上とした場合のアウターループ の開ループ特性を示す。ただし電流制御器は簡単化のため 比例制御とし、アクティブダンピングなしとしている。ここ で、コントローラ側から見た共振周波数はエイリアシング の影響によりナイキスト周波数より低い周波数で発生す る。ここで、エイリアシングにより発生する共振周波数 fr<sup>image</sup>







Fig. 2. Block diagram of grid current feedback control with active damping method.



Fig. 3. Open-loop frequency characteristics of grid-tied inverter.

と元々の共振周波数 fr, サンプリング周波数 fsの関係は以下のように表せる。

図3より、5/6 < f<sub>i</sub>/f<sub>s</sub> < 1(f<sub>i</sub><sup>image</sup>/f<sub>s</sub> < 1/6)の範囲において、位 相が-180°を通過する点でのゲインは0dB未満である。した がって、上記周波数範囲ではシステムは安定となる。しか し、共振周波数付近でゲイン特性がピークとなる。したがっ て共振を励起させないようにループゲインを決定する必要 がある。一方、1/2 < f<sub>i</sub>/f<sub>s</sub> < 5/6(1/6 < f<sub>i</sub><sup>image</sup>/f<sub>s</sub> < 1/2)の範囲にお いて、位相が-180°を通過する点はエイリアシングにより発 生した共振周波数である。したがって、この周波数範囲では 共振を励起しやすく、システムは不安定となりやすい。以上 より、ナイキスト周波数以上の共振周波数を有するシステ ムにおいてもフィルタ共振を抑制するダンピングが必要で ある。

## 〈2・3〉 キャパシタ電流比例フィードバック手法

図 4 にキャパシタ電流比例フィードバック適用時の制御 ブロック図を示す。図 4 中において, *G*<sub>d</sub>(*s*) = exp(-(λ+0.5)*T*<sub>s</sub>*s*) は演算遅延と PWM 遅延を模擬している遅延要素, λは演算 遅延に依存する係数, *K*<sub>t</sub>はダンピングゲインを表している。 本手法ではキャパシタのプラントモデルに対して, 並列に インピーダンスを接続する構成となり, フィルタ共振が減



Fig. 4. Equivalent circuit and detail of active damping method based on capacitor current feedback.



Fig. 5. Frequency characteristics of  $R_{AD}$  by (4). ( $\lambda = 1, K_t > 0$ )



Fig. 6. Inner-loop frequency characteristics with capacitor-current feedback active damping.

衰される。ここで, アクティブダンピングによりフィルタキ ャパシタに並列に挿入される仮想抵抗 *R*<sub>4D</sub> は以下のように 表せる。

上式より,仮想的に挿入される仮想抵抗は遅延の影響に より周波数特性を有することがわかる。

図 5 に $\lambda$ =1における仮想抵抗特性を示す。図 5 より,ナ イキスト周波数以上である 1/2 < *f*,*f*<sub>s</sub> < 5/6 の範囲では正の抵 抗特性の振る舞いとなる。一方,5/6 < *f*,*f*<sub>s</sub> < 1 の範囲では負 性抵抗となり,RHP 極が現れるため安定性が悪化する。

図 6 にナイキスト周波数以上の異なる共振周波数におけ るインナーループの開ループ特性を示す。図 6 より,  $f_i f_s = 0.82$ の場合,エイリアシングにより低い帯域に共振点 が発生する。安定余裕(ゲイン余裕 GM,位相余裕 PM)に着 目すると, $f_i f_s = 0.54$ の場合と比べて GM2 と PM2 は大きく, GM1 と PM1 は小さくなる。一方で, $f_i f_s = 0.54$ の場合,  $f_i f_s = 0.82$ と安定余裕の大小関係が逆転する。したがって, 系統インピーダンス変動による共振周波数の変化を考慮す るとインナーループが安定となる範囲はさらに制限され る。

## 3. 提案制御方式

#### 〈3·1〉 提案制御構成

図 7 に提案制御構成を示す。本提案制御方式はインナー

ループを 0.5 サンプリング遅れであるキャリアのボトムで 更新し、アウターループを 1 サンプリング遅れであるキャ リアのトップで更新する。加えてインナーループのダンピ ングゲイン K<sub>i</sub>を負として正帰還にする。さらに、最小位相 動作範囲拡大のために位相遅れ補償器を付加している。サ ンプリング時間の半分の遅れを考慮したキャパシタ電流の 伝達関数は以下のように表せる。

$$G_{v_o \to i_c}[z, m = 0.5] = \frac{\sin 0.5 \omega_r T_s}{\omega_r L} \frac{z^2 - 1}{z \left(z^2 - 2z \cos \omega_r T_s + 1\right)}.(5)$$

ここで、 $m = 1-\lambda$ である。位相遅れ補償器は Tustin 変換に より離散化され以下のように表せる。

ここで,係数 *a*, *b* は位相遅れ補償器の最大位相 *p*<sub>max</sub> と位相 が最も遅れる角周波数 *p*<sub>max</sub> を用いて以下のように表せる。

$$\begin{cases} a = \frac{1}{b}A\\ b = B + \sqrt{B^2 + A}\\ A = \frac{1 + \cos \omega_{\max} T_s}{1 - \cos \omega_{\max} T_s}, B = \frac{(1 + \cos \omega_{\max} T_s) \tan \phi_{\max}}{\sin \omega_{\max} T_s} \end{cases}$$
(7)

## 〈3·2〉 仮想インピーダンス RAD の 周波数特性

図 8 に(4)に基づいて $\lambda$ =0.5 およびダンピングゲイン $K_t$ を 負とした場合のインピーダンス特性を示す。図 8 より  $1/4 < f_t/f_s < 3/4$ の範囲で正の抵抗特性の振る舞いをする。し たがって、図 5 のキャパシタ電流比例フィードバックと比 較して、正の抵抗範囲が 50%拡大できていることがわかる。

## 〈3·3〉 インナーループ特性

図 9 にナイキスト周波数以上の異なる共振周波数におけるインナーループの開ループ特性を示す。ただし、簡単化のため *GAD* はゲイン *Kt* としている。インナーループの開ループ伝達関数は以下のように表せる。

$$T_{inner}[z] = G_{AD}[z]G_{v_0 \to i_c}[z, m = 0.5] \dots (8)$$

図9より, f,/fs=0.73(f<sup>,image</sup>/fs=0.27)の場合, 安定余裕(GM, PM)が減少していることがわかる。一方で, f,/fs = 0.67 や f,/fs = 0.54 のように共振周波数がナイキスト周波数に近づく と,安定余裕が改善する方向となるため, f,/fs = 0.75 付近で の安定性を確保すればよいことがわかる。そこで,周波数特 性を改善するために位相遅れ補償器を適用する。1 サンプリ ング遅れおよびダンピングゲイン K<sub>t</sub>が正の場合はナイキス ト周波数付近で不安定となり,追加の補償器で安定性を改 善することは困難である。一方で,0.5 サンプリング遅れお よびダンピングゲイン K<sub>t</sub>を負にすることによってナイキス





 Fig. 7. Proposed grid current feedback control with capacitor-current phase lag positive feedback.

 ト周波数よりも低い周波数帯が不安定要素となっているた

め、補償器での安定化が可能である。

# 〈3・4〉 位相遅れ補償器を追加したインナーループの開 ループ特性

図 9 より位相が 180°となる値を位相遅れ補償器により補 償すればいいため, stiff-grid の場合における共振周波数 f,を 最大位相差の周波数 fmax に設定すればよい。次に,安定余裕 (ゲイン余裕,位相余裕)に基づいて(8)のインナーループの開 ループ特性を設計する。まず,ゲイン余裕について検討す る。(8)より,ゲイン余裕 GM は $\angle T_{inner}[z = \exp(j\omega_{ep}T_s)] = \pi と$ なる位相交差角周波数  $\omega_{cp}$ で 10<sup>(GM20)</sup> $|T_{inner}[z = \exp(j\omega_{ep}T_s)] = 1$ となるゲインである。 $\angle T_{inner}[z = \exp(j\omega_{ep}T_s)] = \pi$ より, $\omega_{cp}T_s$ について解くと以下のように求まる。

$$\omega_{cp}T_s = \cos^{-1}\frac{-(1+ab) + \sqrt{(1+ab)^2 + 4(1+a)(1-b)(a-b)}}{2(1+a)(1-b)}$$

したがって、 $10^{(GM/20)}|T_{inner}[z = \exp(j\omega_{cp}T_s)]| = 1$ より、ゲイン余裕 GM に基づくダンピングゲインの最大値は以下のように表せる。

$$K_{t_{-}GM} = 10^{-\frac{GM}{20}} \cdot \omega_r L \sqrt{\frac{1 + a^2 \tan^2 0.5 \omega_{cp} T_s}{1 + b^2 \tan^2 0.5 \omega_{cp} T_s}} \left| \frac{\cos \omega_{cp} T_s - \cos \omega_r T_s}{\sin 0.5 \omega_r T_s \sin \omega_{cp} T_s} \right|$$
(10)

次に位相余裕について検討する。位相余裕 PM はループ ゲインが 1 となるゲイン交差角周波数 $\alpha_{cg}$ における位相と $\pi$ との差である。 $|T_{inner}[z = \exp(j\alpha_{cg}T_s)]|=1$ より,位相余裕に基 づくダンピングゲインの最大値は以下のように表せる。

$$K_{t_{-}PM} = \omega_r L \sqrt{\frac{1 + a^2 \tan^2 0.5 \omega_{cg} T_s}{1 + b^2 \tan^2 0.5 \omega_{cg} T_s}} \left| \frac{\cos \omega_{cg} T_s - \cos \omega_r T_s}{\sin 0.5 \omega_r T_s \sin \omega_{cg} T_s} \right| (11)$$

ただし、 $PM = \pi - \angle T_{inner}[z = \exp(j\omega_{cg}T_s)]$ より、ゲイン交差 周波数は以下の式の解である。

$$\frac{(b-a)\sin\omega_{cg}T_s\tan\left(PM-\omega_{cg}T_s\right)}{(1+ab)+(1-ab)\cos\omega_{cg}T_s} = 1\dots\left(0 < \omega_{cg}T_s < \frac{\pi}{2} + PM\right)$$

(12)に示した値域に解が存在するため、2 分法などを用い てゲイン交差周波数を算出する。以上より、ゲイン余裕およ び位相余裕を満足するダンピングゲイン K,は以下のように して求まる。

図10に位相遅れ補償器の有無におけるインナーループの 開ループ特性をそれぞれ示す。ここで、安定余裕はゲイン余 裕3dB,位相余裕30°とした。位相遅れ補償器を追加するこ とにより安定余裕が改善されることが確認できる。



Fig. 8. Frequency characteristics of  $R_{AD}$  by (4). ( $\lambda = 0.5, K_t < 0$ )



Fig. 9. Inner-loop frequency characteristics with capacitor-current positive feedback with reduced computation delay.



Fig. 10. Inner-loop frequency characteristics with or w/o phase lag compensator.



Fig. 11. Open-loop frequency characteristics of outer-loop.
 〈3·5〉 インナーループの安定余裕によるアウターループへの影響

図 11 にアクティブダンピングの有無におけるアウタール ープの開ループ特性を示す。ここで、アウターループの開ル ープ伝達関数は以下のように表せる。

$$T_{outer}[z] = \frac{G_C[z]z^{-1}G_{v_o \to i_s}[z]}{1 + G_{AD}[z]G_{v_o \to i_c}[z, m = 0.5]} \dots (14)$$

図11より、アクティブダンピングを適用することにより 共振ピークが減少している。さらに、位相遅れ補償器を追加 することによりインナーループの安定余裕が改善され、イ ンナーループゲインを増加させることが可能となるため共 振ピークをさらに減衰させることが可能となる。

# 4. LCL フィルタおよび制御器の設計法

## 〈4·1〉 *LCL* フィルタの設計法

インバータ側インダクタのインダクタンスは電流リプル 率より決定する。今回は電流リプル率が10%から40%まで となるように設計した。次に stiff-grid(系統インピーダンス が0%)および weak-grid(系統インピーダンスが無限大)の共 振周波数に基づき,フィルタキャパシタと系統側フィルタ インダクタのパラメータを決定する。フィルタキャパシタ と系統側フィルタインダクタは以下のように決定される。



ここで,  $f_{r_{stiff}}$ は  $3/4f_s$ 程度,  $f_{r_{weak}}$ は  $1/2f_s$ 程度となるようにフィルタパラメータを設計する。

## 〈4・2〉制御器のパラメータ設計

電流制御器には基本波と 5 次調波を対象にした比例共振 (PR)制御器を用いた。このときの電流制御器の伝達関数を以 下に示す。

$$G_{C}(s) = K_{p} \left( 1 + \frac{1}{T_{r}} \frac{2\omega_{i}s}{s^{2} + 2\omega_{i}s + \omega_{o}^{2}} + \frac{1}{T_{r}} \frac{2\omega_{i}s}{s^{2} + 2\omega_{i}s + (5\omega_{o})^{2}} \right)$$
(17)

ここで、 $K_p$ は比例ゲイン、 $T_r$ は共振時間、 $\omega$ は共振角周波 数幅、 $\omega_o$ は共振角周波数である。共振角周波数は系統角周 波数とする。共振角周波数幅は系統周波数変動を考慮して 系統角周波数の 1%である $\pi$  rad/s とする。PR 制御器は Prewarped Tustin 変換により離散化する。また、クロスオーバー 角周波数 $\omega_c$ は $\omega_r/15$ 、位相余裕は 45°として設計した。

$$K_{p} \cong \omega_{c} \left( L + L_{f} \right) \tag{18}$$

$$T_{r} = \frac{2\omega_{i}\omega_{c}}{\tan\left(PM + 1.5\omega_{c}T_{s} - \frac{\pi}{2}\right)} \cdot \left(\frac{1}{\omega_{o}^{2} - \omega_{c}^{2}} + \frac{1}{\left(5\omega_{o}\right)^{2} - \omega_{c}^{2}}\right)$$
(19)

ダンピングゲインは(13)により決定される。また最大遅れ 位相は電流制御系の代表根が最小となるように設定する。

## 〈4・3〉 系統インピーダンス変動に対する安定性評価

表1に上述した設計に基づいて決定したシステムパラメ ータを示す。系統インピーダンス変動に対するロバスト性 は系統インピーダンスを10%まで変化させて検証する。

図 12 にインナーループとアウターループの開ループ特性

Table I System Parameters

Circuit Parameter		
$V_{dc}$	DC-link Voltage	350 V
$V_g$	Grid Voltage	200 V <sub>ms</sub>
$P_n$	Nominal Power	1 kW
$f_g$	Grid Frequency	50 Hz
$Z_b$	Base Impedance	40 Ω
$C_b$	Base Capacitance	79.6 μF
Switching Device (SiC-MOSFET)		SCT3030AL
N	Number of Level	3
$f_{sw}$	Switching Frequency	150 kHz
f <sub>eq_sw</sub>	Equivalent Switching Freq.	600 kHz
L	Inductor (% $Z_L = 0.048$ %)	61 µH
$C_{f}$	Filter Capacitor (% $Y_{Cf}=0.088\%$ )	0.07 µF
$L_{f}$	Filter Inductor (% $Z_{Lf} = 0.048\%$ )	61 µH
$f_{r \ stiff}$	LCL Resonance Frequency	108.9 kHz
fr weak	LCL Resonance Frequency	77 kHz
Controller Parameter		
$f_s$	Sampling Frequency	150 kHz
$f_c$	Crossover Frequency	10 kHz
PM	Phase Margin	45 deg.
K <sub>p</sub>	Proportional Gain	7.67 Ω
$T_r$	Resonance Period	1.26 ms
$f_i$	Resonance Frequency Width	0.5 Hz
$\phi_{\rm max}$	Maximum Phase of Lag comp.	-36.6 deg.
K	Damping Gain	-23.73 Ω





を示す。系統インピーダンス変動時においても安定余裕が 保たれていることが確認できる。図 12(b)より, Stiff-grid 時 (青)において,位相余裕の設計値に対して位相特性が改善し ている。これは,インナーループの位相遅れ補償器によるに よるものである。したがって,アクティブダンピングの適用 により,開ループの安定余裕が強化される。Weak-gird 時(赤) のアウターループの開ループゲインおよび位相余裕の改善 は今後の課題である。

図 13 に系統インピーダンス変動時のシステムの根軌跡を 示す。単位円内に極が位置することから系統インピーダン スにロバストであることがわかる。

## 5. 実験結果

図 14 に定常動作波形を示す。系統インピーダンスによら ず,電流 THD は 5%以下となり,連系規程を満足している。

図 15 にアクティブダンピング適用時の動作波形を示す。 図 15(a)より, Stiff-grid 時においてアクティブダンピングを 適用しない場合,フィルタ共振が発生し,共振電流が系統電 流に重畳していることがわかる。一方で,図 15(b)において, weak-grid 時についてはアクティブダンピングの有無に関係 なく共振は確認されない。これは、デッドタイムや素子の寄



Fig. 13. Root locus of grid current feedback system when grid inductance is varied.



Fig. 14. Steady-state operation waveforms with active damping.



(a) Stiff grid at  $\%Z_g = 0\%$  ( $L_g = 0$  mH). (b) Weak Fig. 15. Inverter operation waveforms when active damping is disabled from enabled.

生成分により共振自体が減衰したためである。Stiff-grid 時に おいてもこれらの影響があるが、システムの高いループゲ インによって十分に共振を抑制できない。

## 6. おわりに

本論文では、ナイキスト周波数以上の LCL 共振周波数を 有する系統側電流フィードバック制御方式における電流制 御法を提案した。提案制御法は共振周波数を高く設定する ことが可能なため LCL フィルタの体積を削減可能である。 実機検証より、系統インピーダンス変動時にロバストであ り、電流 THD は 5%以下となり連系規程を満足している。

# 文 献

- (1) X. Wang, et al: *IEEE Trans. PE*, vol. 29, no. 12, pp. 6421-6432
- (2) IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces," in *IEEE Std 1547-2018 (Revision of IEEE Std 1547-2003)*, vol., no., pp.1-138, 6 April 2018
- (3) IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems," in *IEEE Std 519-2014* (*Revision of IEEE Std 519-1992*), vol., no., pp.1-29, 11 June 2014
- (4) W. Wu, et al: *IEEE Trans. IE*, vol. 60, no. 10, pp. 4339-4350, (2013)
- (5) W. Yao, et al: *IEEE Trans. PE*, vol. 35, no. 3, pp. 3114-3126, (2020)
- (6) D. Pan, et al: *IEEE Trans. IE*, vol. 62, no. 3, pp. 1537-1547, (2015)
- (7) W. Wu, et al: *IEEE Trans. IE*, vol. 64, no. 9, pp. 7402-7413, (2017)
- (8) L. Harnefors, et al: *IEEE Trans. IE*, vol. 64, no. 8, pp. 6362-6370
- (9) Y. Tang, et al: IEEE Journal of ESTPE, vol. 4, no. 1, pp. 3-14, (2016)



(b) Weak grid at  $%Z_g = 10\% (L_g = 12.7 \text{ mH}).$ 

